(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002年12月27日(27.12.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/104080 A1

(51) 国際特許分類7: H05B 33/14, C09K 11/06

(21) 国際出願番号:

PCT/JP02/05891

(22) 国際出願日:

2002年6月13日(13.06.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2001-181416 2001年6月15日(15.06.2001) 特願2002-143441 2002年5月17日(17.05.2002) JP 2002年5月17日(17.05.2002) 特願2002-143442 特願2002-143443 2002年5月17日(17.05.2002)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): キヤノ ン株式会社 (CANON KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒146-8501 東京都 大田区 下丸子3丁目30番2号 Tokyo (JP).

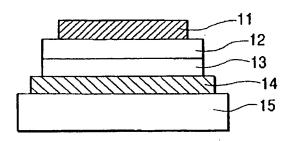
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 古郡 学 (FU-RUGORI, Manabu) [JP/JP]; 〒243-0004 神奈川県 厚木市 水引2丁目 6-29 キヤノン第一本厚木 寮 Kanagawa (JP). 岡田 伸二郎 (OKADA, Shinjiro) [JP/JP]; 〒259-1141 神奈川県 伊勢原市 上粕屋2639-3 Kanagawa (JP). 坪山明 (TSUBOYAMA, Akira) [JP/JP]; 〒229-0011 神奈川県 相模原市 大野台6丁目5 グ リーンスクエア大野台4-104 Kanagawa (JP). 滝口 隆雄 (TAKIGUCHI,Takao) [JP/JP]; 〒157-0064 東 京都 世田谷区 給田1丁目10-2 Tokyo (JP). 三浦 聖志 (MIURA,Seishi) [JP/JP]; 〒229-0015 神奈川 県 相模原市 下溝327-16 Kanagawa (JP). 森山 孝志 (MORIYAMA, Takashi) [JP/JP]; 〒215-0005 神奈川県 川崎市麻生区 千代ヶ丘4丁目2-31 アメニティパレ スB棟202 Kanagawa (JP). 井川 悟史 (IGAWA,Satoshi) [JP/JP]: 〒251-0044 神奈川県 藤沢市 辻堂太平台2丁目 3-24 Kanagawa (JP). 鎌谷淳 (KAMATANI, Jun) [JP/JP]; 〒215-0011 神奈川県 川崎市麻生区 百合丘3丁目 26-4 Kanagawa (JP). 岩脇 洋伸 (TWAWAKI,Hironobu) [JP/JP]; 〒243-0004 神奈川県 厚木市 水引2丁目6-29 キヤノン第一本厚木寮 Kanagawa (JP).

- (74) 代理人: 岡部 正夫 . 外(OKABE, Masao et al.); 〒 100-0005 東京都 千代田区 丸の内3丁目2番3号 富士 ビル602号室 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG. BR. BY. BZ. CA. CH. CN. CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

/続葉有/

- (54) Title: ORGANIC ELECTROLUMINESCNECE DEVICE
- (54) 発明の名称: 有機エレクトロルミネッセンス素子



(57) Abstract: A technique for improving the dispersability of the emitting material in the emitting layer so as to improve the emission efficiency and emission life of an organic electroluminescence device. The electroluminescence device comprises electrodes disposed on a substrate and composed of an anode and a cathode and an organic emitting layer disposed between the electrodes and is characterized in that the emitting layer contains an emitting material and a dopant for improving the dispersability of the emitting material. The dopant can be a combination of an emitting compound and a nonemitting compound or can be a current promoting material. Such a dopant is used together with the emitting material. When the combination of an emitting compound and a nonemitting compound is used, the emitting layer resultantly contains two emitting materials. In this case, the wavelengths of the lights emitted by the emitting materials are preferably nearly the same. When the emitting material and the dopant are put in one evaporation boat and evaporated, the evaporation temperature is low, the dispersability of the emitting material is improved. The characteristics are also improved. Consequently, the emission efficiency is high, and the emission life is long.

/続葉有]

ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,

LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類: — 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

有機エレクトロルミネッセンス素子の発光効率と発光寿命を改善するために、発光層中の発光材料の分散性を改善する手法を提供する。その構成は、基板上に配置された陽極および陰極からなる電極と、前記電極間に有機発光層を有する発光素子であって、前記発光層が発光材料とその分散性を改善するためのドーパントを含むことを特徴とする発光素子である。このドーパントとして、発光性化合物と非発光性化合物、あるいは電流促進材料を発光材料と共に用いる。前記発光性化合物の場合は、発光材料を複数用いることと同じであるが、この場合は発光波長が近似している方が良い。また発光材料とドーパントを1つの蒸着用ボートに入れて蒸着することにより、蒸着温度が低下し、発光材料の分散性が向上して、さらに特性の改善が得られた。このことによって、発光効率が高く、発光寿命の長い発光素子が得られる。

明細書

有機エレクトロルミネッセンス素子

5 技術分野

本発明は、有機化合物を用いた発光素子に関するものであり、さらに詳しく は複数の化合物を発光層内にドープすることによる、輝度・効率・駆動耐久性 の高い発光素子、特に有機エレクトロルミネッセンス素子(有機EL素子)に 関するものである。

10

20

背景技術

有機EL素子は、高速応答性や高効率の発光素子として、応用研究が精力的に行われている。その基本的な構成を図1A、1Bおよび1Cに示した[例えばMacromol. Symp. 125, 1~48 (1997) 参照]。

15 図1A、1Bおよび1Cに示したように、一般に有機EL素子は透明基板1 5上に設けられた、透明電極14と、金属電極11と、それらの間に挟持され た複数層の有機膜からなる有機層とで構成される。

図1Aでは、有機層が発光層12とホール輸送層13からなる。透明電極14としては、仕事関数が大きなITOなどが用いられ、透明電極14からホール輸送層13への良好なホール注入特性を持たせている。金属電極11としては、アルミニウム、マグネシウムあるいはそれらを用いた合金などの仕事関数の小さな金属材料を用い、発光層12への良好な電子注入性を持たせる。これら電極には、50~200nmの膜厚が用いられる。

発光層12には、電子輸送性と発光特性を有するアルミキノリノール錯体な 25 ど (代表例は、下記に示すAla3) が用いられる。また、ホール輸送層13 には、例えばピフェニルジアミン誘導体 (代表例は、下記に示す α-NPD)

など電子供与性を有する材料が用いられる。

以上の構成を有する素子は整流性を示し、金属電極11を陰極に透明電極14を陽極になるように電界を印加すると、金属電極11から電子が発光層12に注入され、透明電極14からはホールがホール輸送層13を介して発光層12に注入される。

注入されたホールと電子は発光層12内で再結合により励起子を生じ、このため発光がおこる。この時ホール輸送層13は電子のブロッキング層の役割を果たし、これにより発光層12/ホール輸送層13界面での再結合効率が上がり、発光効率が上がる。

- 10 さらに、図1Bでは、図1Aの金属電極11と発光層12の間に、電子輸送 層16が設けられている。これにより発光と電子・ホール輸送を分離して、よ り効果的なキャリアプロッキング構成にすることで、効率的な発光を行うこと ができる。電子輸送層16としては、例えば、オキサジアゾール誘導体などを 用いることができる。
- これまで、一般に有機EL素子に用いられている発光は、発光中心の分子の 一重項励起子から基底状態になるときの蛍光が取り出されている。一方、一重 項励起子を経由した蛍光発光を利用するのでなく、三重項励起子を経由した燐 光発光を利用する素子の検討がなされている。発表されている代表的な文献は、 文献 1: Improved Energy Transfer In Electrophosphorescent Device
- 20 (D. F. O' Brien 5, Applied Physics Letters Vol. 74, No. 3, p. 422 (1999)),

文献 2: Very High-efficiency Green Organic Light-emitting Devices Based On Electrophosphorescence (M. A. Baldoら、Applied Physics Letters Vol.75. No. 1, p. 4 (1999))である。

25 これらの文献では、図1Cに示す4層構成の有機層が主に用いられている。 それは、陽極側からホール輸送層13、発光層12、励起子拡散防止層17、 電子輸送層16からなる。用いられている材料は、下記に示すキャリア輸送材料と燐光発光性材料である。各材料の略称は以下の通りである。

A1a3:アルミーキノリノール錯体

 α -NPD:N4,N4'ージナフタレン-1-イル-N4,N4'ージフェ

5 ニルービフェニルー4,4'ージアミン

CBP: 4, 4'-N, N'-ジカルパゾールーピフェニル

BCP: 2, 9-ジメチルー4, 7-ジフェニルー1, 10-フェナントロリ

ン

P t OEP: 白金ーオクタエチルポルフィリン錯体

10 Ir (ppy):イリジウム-フェニルピリジン錯体

Ir(ppy)3

さらに、Forrest. et al., Nature, 403, p 750 には積層構造の BL 素子に 於いて発光層のホスト材料としてCBPを用い、 $Ir(ppy)_3$ の緑発光材 料層からDCM(ジシアノメチレン)の赤色発光層に三重項と一重項間のエネ ルギー転移をさせる方式が示されている。

5 これらと本発明との差異は、共存する発光材料の発光波長が離れている点、 また形成方法が混合物を真空蒸着していない点などであり、詳細は実施例等で 詳述する。

上記、燐光発光を用いた有機EL素子では、低電圧で電子・正孔のバランスを保ちながら、低い電圧でより多くのキャリアを発光層に注入することが高輝10 度化・高効率化に重要な課題である。

しかし、上記燐光材料の中には電荷注入性および電荷輸送性が低く、低電圧で多くの電流を流すことが困難なものもあった。

また、一般に多くの有機材料は蒸発時に複数分子の集合体(クラスター)を形成することが知られており、このようなクラスターを形成している発光層は、 局所的に発光材料の濃度が高くなり、これが素子の発光効率を下げる原因となると考えられている。

さらに、有機材料はたとえば、発光層中で同種分子同士の結晶化等により特性の劣化が起こることが問題となっていた。

以上の背景により、高い発光輝度が得られ、また長寿命である発光素子を実 20 現することが望まれている。

発明の開示

15

25

本発明は上記背景技術を改良することを目的にして、有機発光材料を用いた 有機EL素子において、低電圧駆動を可能にし、高輝度化・高効率化・高耐久 性を可能にする発光素子を提供することを目的とする。

本発明は、基板上に配置された陽極および陰極からなる電極と、前記電極間



に有機発光層を有する発光素子であって、前記発光層が発光材料とその分散性 を改善するためのドーパントを含むことを特徴とする発光素子である。

また本発明は、前配ドーパントが発光性化合物で構成され、かつ前記発光材料の発光波長スペクトルと前記発光性化合物の発光波長スペクトルが主要な部分で重なりを有することを特徴とする発光素子である。

前記発光材料および発光性化合物の発光波長と量子収率の関係が、発光波長の短い方の量子収率が発光波長の長い方の量子収率より大きいことが好ましい。

前記発光材料および発光性化合物の少なくとも1種が、金属錯体および/ま 10 たは有機化合物であり、各々のHOMO準位が異なることが好ましい。

これらの発光材料と発光性化合物の発光スペクトルのピーク波長の差が3 0 nm以下であることが好ましい。

前記発光材料と発光性化合物は、同一の配位子骨格を有し配位子骨格の置換 基がそれぞれ異なる複数の金属錯体で構成されることが好ましく、金属錯体の 中心金属はイリジウムであることが好ましい。

また本発明は、発光材料と発光性化合物を混合して1つの加熱容器に入れて、 真空蒸着することを特徴とする製造方法である。

また本発明は、前記ドーパントが非発光性化合物からなることを特徴とする発光素子である。

20 前記非発光性化合物が前記発光材料より低沸点の化合物であることが好ましい。

前記非発光性化合物のバンドギャップが前記発光材料のバンドギャップよりも大きいことが好ましい。

有機発光層中の発光材料と前記非発光性化合物の割合を、有機発光層内の場 25 所により変化させることが好ましい。発光材料が燐光発光材料であることが発 光効率の上で好ましい。



さらに本発明は、前記有機発光層が発光材料と電流促進材料を含むことを特 徴とする発光素子である。

前記電流促進材料が発光性材料であり、その量子収率が前記発光材料よりも低いことが好ましく、また発光スペクトルのピーク波長の差が30nm以下であることが好ましい。

前記電流促進材料のバンドギャップが、前記発光材料のバンドギャップより も大きいことが好ましい。

図面の簡単な説明

10 図1A、1Bおよび1Cは、本発明の発光素子の一例を示す概念図である。 図1Aは有機層が2層の素子構成、図1Bは有機層が3層の素子構成、図1C は有機層が4層の素子構成を示す。

図2は、本発明に用いた発光材料と発光性化合物の発光スペクトル図を示す。 この場合Ir錯体CとIr錯体Dのスペクトルを示す。横軸が発光波長であり、

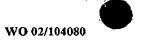
15 縦軸は発光ピークで規格化した値である。発光スペクトルの主要な領域が重な り合っていることが判る。

図3は、比較例の発光スペクトルを示す図である。発光スペクトルの重なり 合いが少なく、ピーク波長も離れている様子が判る。

20 発明の実施の形態

本発明の発光素子は、陽極および陰極と、陽極および陰極間に挟持された有機発光層を有する発光素子である。有機発光層の層構成は特に限定されず、図 1 A、1 B および 1 C に示す様な構成が挙げられる。

本発明の発光素子は、有機発光層が発光材料と発光材料の分散性を改善する 25 ためのドーパント、特に発光性化合物、あるいは非発光性化合物、または電流 促進材料を含むことを特徴とする。上記ドーパントの役割としては、



15

20

25

- (1) キャリアの注入やキャリアの移動がおこりにくい発光層、例えば、燐光 発光材料を用いた発光層を用いた素子においても、素子電流を増加させ ることにより、駆動電圧の低下や発光の高効率化を図る、
- (2) 発光層中での結晶化反応を抑制することにより長寿命化を図る、
- 5 (3)発光材料と共に蒸着することで蒸着温度を下げる、
 - (4) 発光層中の発光部位を変化させることにより輝度の増加等を図る、といった改善効果をもたらすことが挙げられる。

本発明の発光素子は、有機発光層以外の構成が同様の発光素子と比較したとき、有機発光層が単一の発光材料のみでなく、発光材料および発光性化合物からなる混合発光層を持つことから、同等の電圧を印加した際により多くの電流が流れる、もしくはより大きな発光輝度が得られる、また連続駆動した際に長時間の耐久性を持つ、といった特徴がある。

ドーパントとしては、それが発光性化合物である場合、その発光量子収率が 主たる発光材料よりも低いものを用いるのが良い。これにより、主たる発光材 料が発光輝度の大部分を与え、ドーパントである発光性化合物からの発光輝度 を小さくすることができる。

ドーパントの第二の機能としては、発光層中の発光材料の存在を安定化させる機能がある。このとき発光性化合物は発光材料と異なる分子構造をもち、基底状態での結晶化もしくは二量体化反応、励起状態での会合体形成を阻害する化合物であることが望ましい。例えば金属錯体の構造について言えば、基本骨格は変わらないで、異なる置換基を持つ化合物など、発光材料と発光特性は似通っていて、かつ分子構造が異なる化合物が望ましい。

ドーパントの第三の機能としては、蒸着時の分子流の制御機能がある。蒸発 温度の異なる複数の材料を混合して加熱蒸着することにより、発光材料が蒸発 時に、微結晶のようなクラスターを形成するのを抑制することができる。たと えば、フッ素化された有機化合物を発光材料と同時に蒸着するとこの効果が期



待できる。

たとえばフッ素化されたイリジウム錯体の配位子としては次のような化合物が考えられる。

5

ドーパントとして発光性化合物を用いた場合には、なるべく単一の発光色を 得ることが重要である。特に発光材料の発光波長スペクトルと主要な部分が重 なり合うこと、あるいは発光スペクトルのピーク波長の差が30nm以下であ ることが好ましい。

10 何えば発光材料が赤発光の場合、発光材料と発光性化合物との発光強度比を 10:1とすると、シミュレーションの結果から発光スペクトルのピーク波長 の差が30 nm以下ならば、CIE座標が大きく変化しないことが確かめられ ている。よって、色純度の高い発光を得るという観点からは発光材料と発光性 化合物の発光スペクトルのピーク波長の差が30 nm以下であることが好ま しい。

こうすれば発光材料および発光性化合物の双方が発光した場合でも、色純度 の変化が少ない素子が作製できる。また、発光性化合物から発光材料にエネル ギー転移が起こるような場合、エネルギー差が少ないためエネルギー転移が起 こりやすいという利点がある。

20

また、発光性化合物のバンドギャップを、発光材料のバンドギャップよりも 大きくすることにより、正孔と電子が発光性化合物よりも発光材料上で再結合 を起こしやすくなり、主として発光材料からの発光を得ることができる。

本発明においては、発光材料と発光性化合物の割合を、有機発光層内の場所



により変化させれば、発光層内の電子および正孔の分布をコントロールすることができ、発光層内の電子一正孔の再結合位置を調整することが容易になる。 これにより、発光色のよい、高効率の素子を作製することができる。

なお本発明における非発光性化合物とは、上記発光性化合物に比べて発光性 が著しく劣るもので、単独では EL 発光せず、EL 素子の発光に寄与しないもの をいう。

ここで発光層の組成について述べると、一般には電気伝導性を有するホスト 材料中に発光材料を分散させて用いるが、発光材料のみでも構成可能である。 そして、本発明では、これにさらにドーパントを加えることが特徴である。ホ スト材料としては、例えばCBP、TAZ等があり、本発明で用いる発光性化 合物としては、例えば化合物A、CBP、Ir錯体A等が挙げられる。

発光材料としては、例えば I r 錯体B, I r (ppy) $_3$ 、 I r 錯体C 等を用いることができる。

前記に示したもの以外の構造は、以下の通りである。

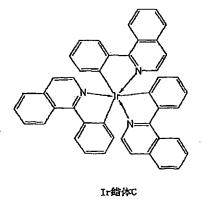
10

WO 02/104080

化合物A

Ir錯体A

Ir錯体B



実施例

5 実施例1、実施例2に用いた素子作製工程の共通部分を説明する。

本実施例では、素子構成として、図1Cに示す有機層が4層の素子を使用した。ガラス基板(透明基板15)上に厚み100nmのITO(透明電極1

- 4) をパターニングした。そのITO基板上に、以下の有機層と電極層を
- 10⁻¹Paの真空チャンバー内で抵抗加熱により真空蒸着し、連続製膜した。

10 ホール輸送層13 (40nm): α-NPD

発光層12(40nm):ホスト材料+発光材料+発光性化合物



励起子拡散防止層17(10nm):BCP

電子輸送層16 (30nm):Alq3

金属電極層1 (15nm):AlLi合金(Li含有量1.8重量%)

金属電極層2 (100nm): A1

5 対向する電極面積が3mm¹になるようにパターニングした。

実施例1

発光層のホストとしてCBPを用い、発光材料としてIr錯体Cを7重量%の濃度で、さらに発光性化合物としてIr錯体Aを3重量%となるように発光10. 層にドープして素子を作製した。ここで用いたIr錯体Aは、素子に流れる電流を増大させる機能があり、電流促進材料としての働きも兼ね備えている。

(比較例11)

発光性化合物の Ir 錯体Aをドープしない以外は、実施例 1 と同様にして、素子を作製した。

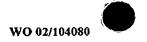
15 これらの素子に10Vの直流電圧を印加して、そのときの電流および輝度を 測定した結果を表1に示す。

表1

	電流	(mA/cm²)	輝度	(cd/m^2)
実施例1		80. 2		806
比較例11		11.8		426

20 発光性化合物として、Ir錯体Aを加えた実施例1は、電流・輝度共に上昇した。また素子電流が大幅に増加していることから、Ir錯体Aの電流促進効果も確認できた。

発光スペクトルはIr錯体Cの発光の他にIr錯体Aからの発光も現れた。



Ir錯体Cは620nmがピークの発光スペクトルを持ち、Ir錯体Aは61

0 nmをピークとする発光スペクトルである。発光スペクトルのピークの差が

30nm以下であるため、CIE座標では大きな変化はなかった。

錯体Aの量子収率は0.3であるのに対して、Ir錯体Cの量子収率は0.

5 66である。ここで、量子収率は次のように決定した。

 Φ (sample) $/\Phi$ (st)

=[Sem (sample) / Iabs (sample)]/[Sem (st) / Iabs (st)]

Φ (sample) :測定試料の量子収率

Φ (st) : 標準物質の量子収率

10 labs (st) :標準物質の励起する波長での吸収係数

Sem (st) :同じ波長で励起した時の標準物質の発光スペクトル面積強度

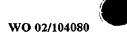
labs (sample) : 測定試料の励起する波長での吸収係数

Sem (sample) :同じ波長で励起した時の測定試料の発光スペクトル面積

強度

実施例2

20 発光層のホストとしてCBPを用い、発光層40nmのうちホール輸送層側の厚み10nmの領域に発光材料としてIr錯体Cを7重量%の濃度で、また発光性化合物としてIr錯体Aを3重量%で発光層にドープした。残りの30



nmにはIr錯体Cのみを7重量%の濃度で共蒸着して素子を作製した。ここで用いたIr錯体Aは、素子に流れる電流を増大させる機能があり、電流促進材料としての働きも兼ね備えている。

この素子と、比較例11の素子に10Vの直流電圧を印加して、そのときの 電流および輝度を比較した結果を表2に示す。

表2

	電流(mA/cm²)	輝度(cd/m²)
実施例2	23.5	621
比較例11	· 11.8	426

表2から比較例11に比べて、実施例2の素子は電流・輝度が共に上昇し、 30 発光層の1部に発光性化合物をドープした場合でも電流・輝度の増加作用があることが確認された。ここでIr錯体AとIr錯体Cの量子収率およびパンド ギャップを次表に示す。Ir錯体Aの方がバンドギャップが大きく量子収率は 小さい。

15 表 3

20

	量子収率	バンドギャップ
Ir錯体A	0.3	2.02 e V
I r 錯体 B	0.66	2 e V

実施例1と実施例2を比較すると、実施例2の発光スペクトルは実施例1に 比べて、Ir錯体Aからの発光が弱くなり、Ir錯体Cからの発光の比率が高 くなった。これは電流促進効果によって、正孔の注入が容易になり、電子-正 孔の再結合および発光がIr錯体Cで主に起こるようになったためである。

実施例3

WO 02/104080

本実施例では、素子構成として、図1 Cに示す有機層が4層の素子を使用した。ガラス基板(透明基板15)上に厚さ100nmのITO(透明電極14)を成膜してパターニングした。そのITO基板上に、以下の有機層と電極層を10⁻¹Paの真空チャンパー内で抵抗加熱による真空蒸着し、連続製膜した。ホール輸送層13(40nm):FL03(次構造式)

10 発光層12 (40 nm):ホスト材料+発光材料1+発光材料2 電子輸送層17 (50 nm) Bphen(次構造式)

電子注入層16 (1nm): KF

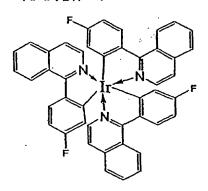
15 金属電極層 (100nm): A1

対向する電極面積が3mm¹になるようにパターニングした。

発光層 12 の形成においては、発光材料 1 として 1 r 錯体 C 、発光材料 2 として 1 r 錯体 D を用いた。

(Ir鐟体D)

WO 02/104080



I r 錯体 C および I r 錯体 D を等量秤量し、メノウ乳鉢で結晶形を小さくしな がら撹拌、混合して混合物粉体を作成した。

この混合物粉体を蒸着用ボートに投入し、ホスト材料としてCBPと共蒸着を行った。上記のIr錯体CとIr錯体Dの混合物が重量比7%になるような条件でホスト材料と共蒸着した。

このようにして作った素子の特性を下記に示す。

10 (比較例31)

発光材料として発光材料1のIr 錯体Cのみを用いた。

(比較例32)

発光材料として発光材料2のIr錯体Dのみを用いた。 このような素子の評価結果を次表にしめす。

表4

[輝度10	初期10		
		,,,,,,			O O cd/m²
-	発光材料		電流効率	電力効率	での輝度
	_	電圧(v)	(cd/A)	(lm/W)	半減時間
	·				(hour)
実施例3	I r錯体C+I r錯体D	5.7	13.5	7.6	52
比較例31	I r 錯体C	.5	7.6	4.8	50
比較例32	I r 錯体D	7.5	6.8	2.9	5.4

本実施例の素子では100cd/m²の輝度で発光するための駆動電圧は5.7Vであって、比較例31の5Vと比べてやや高いものの、比較例32の7.5Vに比べて大幅に低電圧化されている。

さらに電流効率 (単位は c d/A) においても13.5 c d/A と比較例31の7.6 c d/A、比較例32の6.8 c d/A に比べて大幅に上昇している。

これは電力効率においても同様であり、比較例31の4.81m/W、比較例32の2.91m/Wに比べて、本実施例は7.61m/Wと非常に高効率な素子を作成することに成功している。

さらに、その素子の初期輝度1000cd/m²からの連続駆動における輝度 半減時間を調べたところ、比較例31の50時間、比較例32の5.4時間に 比べて52時間と大幅に改善することに成功している。輝度半減時間は比較例 32の10倍の改善があり本発明の効果が特に大きいと考えられる。

15 本実施例の I r 錯体 C の量子収率は 0.66 であるのに対して、I r 錯体 D の量子収率は 0.92 である。発光波長ピークは I r 錯体 C のは 620 n m で あるのに対して、I r 錯体 D は 595 n m である。

しかしながら、発光波長がIr錯体Dと同じく595nmであるが、量子収



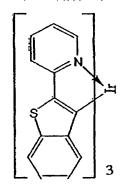
率が0.29と低いIr錯体Iを用いた場合には、300cd/m²の輝度での発光効率、半減寿命ともIr錯体Dを用いた物に比べて劣る。よって発光波長の短い発光材料の量子収率が、発光波長の長い発光材料の量子収率より大きいことがより望ましいことが分かった。

5

表5

فياد لما عاد ما	効率(300cd/m²)	半減寿命
発光材料	cd/A	(時間)
Ir錯体C+Ir錯体D	11.1	93
Ir錯体C + Ir錯体 I	8.3	18.2

(Ir錯体I)

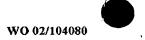


10 本実施例に用いたイリジウム錯体の最高被占軌道(以下HOMOと略す)準位および最低空軌道(以下LUMOと略す)準位を調べると次表の様になっている。

表6

	Ir錯体c	Ir錯体d
HOMO(eV)	-5.13	-5.32
LUMO(eV)	-2.47	-2.6

15 イリジウム錯体CはHOMO準位、LUMO準位共にイリジウム錯体Dのそれより高くなっている。



ここでの電子準位の測定はサイクリックボルタンメトリ法による酸化還元電位の測定(測定機器名 Electrochemical Interfase S I 1287 : Solar tron 社製)と光吸収によるバンドギャップ測定データを基に、別途測定した I r 錯体 C の H O M O 測定(測定器名 A C-1 理研機器製)による結果との照合換算によって決定した。

次に本実施例に用いた I r 錯体 C および I r 錯体 D のホトルミネッセンス (トルエン希薄溶液中での光励起発光スペクトル)を図2に示すが、これら二 つの化合物の発光スペクトルは非常に近接しており、発光波長スペクトルの主要な部分は重なりあっている。このように非常に近接した発光波長を持つ発光 材料を用いることで、色ずれが目立たない。

本発明に用いた I r 錯体 C および I r 錯体 D の真空中での蒸発温度は、それ ぞれ、267度、234度であり、一般にフッ素原子のついたイリジウム錯体 の方が蒸発温度が低い。本発明のひとつの特徴は、蒸発温度の異なる発光材料 を混合して同一るつぼ上で蒸発させることにより、蒸発時の分子流の制御 (例えばクラスターサイズの制御) ができると考えられる。

さらに、本実施例の蒸着に必要な加熱容器に流す電流量を調べると、混合物 の方が電流量が低く、蒸着時の熱による衝撃が少なくなっていることが分かる。 この結果を次表に示した。

表7

10

15

20

発光材量	効率 cd/A	ボート電流 アンペア
lr錯体c	6.5	56.1
ir錯体c+ir錯体d	12.8	53.7

(比較例33)

Ir錯体CおよびIr錯体Dを異なるボートから加熱した場合との比較を 次表に示した。

表8

WO 02/104080

		輝度100cd/m²時の特性			
•	発光材料の蒸着 方法	電圧 (v)	電流効 率 (cd/A)	電力効率 (lm/W)	
実施例3	同一ボート	5.7	13.5	7.6	
比較例33	別ボート	5.5	9.6	5.8	
比較例31	I r 錯体 C のみ	5	7.6	4.8	

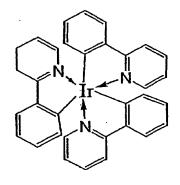
I r 錯体Cのみを蒸着した場合と比べ、I r 錯体Dとの混合発光層を別ボート上から蒸着した場合でも、電流効率、電力効率は改善している。一方本実施例3の場合、2種の錯体を同一ポートで混合し蒸着した場合には、比較例31、33に比べてさらに電流効率、電力効率が改善されている。これは、蒸着時の温度が混合物を用いることで低下し、蒸着温度が低下して膜質が改善したためと考えている。

(比較例34)

5

10 次の比較例としてIr錯体G(次構造式)とIr錯体Cを混合した上で蒸着 して素子を作った。

(Ir錯体G)



Ir錯体Gは514nmの発光ピークを持つが、Ir錯体Cは620nmに発光ピークを持つことから、図3に示すように発光スペクトルの重なりは少ない。本比較例の場合、電流効率、電力効率ともに本実施例よりも低いことが分かる。このことから、発光材料それぞれの発光波長の重なり部分が非重なり部分より大きいことにより素子特性を向上させることができることが分かった。

20

・ 表 9

		輝度100cd/m³時の特性			
発光材料		電圧(v)	電流効率	電力効率	
!			(cd/A)	(lm/W)	
比較例34	I r錯体C + I r錯体G	6.3	10.5	5.4	
実施例3	I r錯体C+I r錯体D	5.7	13.5	7.6	

実施例4

本実施例では、素子構成として、図1 C に示す有機層が4層の素子を使用した。ガラス基板(透明基板15)上に厚さ100nmのITO(透明電極14)をパターニングした。

そのITO基板上に、以下の有機層と電極層を10⁴Paの真空チャンパー 内で抵抗加熱による真空蒸着し、連続製膜した。発光層には、複数の発光材料 を用いた。

15 ホール輸送層13(40nm): FL03

発光層12(40nm):ホスト材料+発光材料1+発光材料2+

発光材料3+発光材料4

電子輸送層 1 7 (50 n m) Bphen

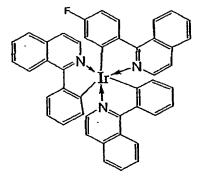
電子輸注入層16 (1nm): EF

20 金属電極層(100nm):Al

対向する電極面積が3mm¹になるようにパターニングした。

本実施例においては、発光材料1としてIr錯体 C、発光材料2としてIr 錯体Dを用いた。発光材料3としてIr錯体E(次構造式)を用いた。

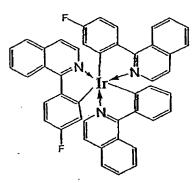
(Ir錯体E)



5

発光材料 4 として I r 錯体 F (次構造式) を用いた。

(Ir錯体F)



10

15

Ir錯体 Cおよび Ir錯体 D、Ir錯体 E、Ir錯体 Fを 3:1:2.5:3.5の 割合で混合して混合物粉体を作成した。この混合物粉体を蒸着用ボートに投入してホスト材料として CBPと共蒸着を行った。ホスト材料に対して上記の Ir錯体の混合物を重量比7%になるように成膜した。このようにして作った素子の特性を次に示す。

これらの評価結果を表10に示す。



表10

15

	: •	輝度10	初期1000		
	発光材料	電圧(v)	電流効率 (cd/A)	電力効率 (lm/W)	度半減時間
<u></u>					(hour)
実施例4	Ir錯体C,D,E,F	4.2	11.7	8	116
比較例31	I r錯体C	5	7.6	4.8	50
比較例32	I r錯体D	7.5	6.8	2.9	5.4

本実施例の素子では 100 c d/m^2 の発光輝度を出す駆動電圧は4.2 Vであり、比較例3105 V、比較例3207.5 Vに比べて大幅に改善されている。さらに電流効率(単位はc d/A)においても11.7 c d/A と比較例3107.6 c d/A、比較例3206.8 c d/Aに比べて大幅に上昇しており、これは電力効率においても同様であって、高効率な素子を作成することに成功している。

さらに、その素子の初期輝度1000cd/m²からの連続駆動における輝度 10 半減時間を調べた。比較例31の50時間、比較例32の5.4時間に比べて、 116時間と大幅に改善することに成功している。輝度半減時間は比較例の2 倍から20倍以上の改善があり本発明の効果が特に大きいと考えられる。

さらに、本実施例の蒸着ボートに流す電流量を調べると、混合物の方が電流 量が低く、発光層の成膜時の温度が低く、熱ダメージが少なくなっていること が分かる。

この結果を次表に示した。

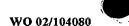


表11

発光材量	ボート電 流 アンペア
Ir錯体C	56.1
Ir錯体C,D,E,F	55.7

実施例5

5 本実施例では、素子構成として、図1Bに示す有機層が3層の素子を使用した。ガラス基板(透明基板15)上に厚み100nmのITO(透明電極14)をパターニングした。

そのITO基板上に、以下の有機層と電極層を10⁴Paの真空チャンバー 内で抵抗加熱による真空蒸着し、連続製膜する。

10 ホール輸送層13 (40 nm): FL03 、

発光層12(40nm):ホスト材料+発光材料1+発光材料2

電子輸送層17 (50 nm) Bphen

金属電極層 (100nm): A1

対向する電極面積が3mm²になるようにパターニングした。

15 本実施例においては、発光材料1として化合物 C (略称D C M) を用いる。 (化合物 C)

発光材料1の他の例としては次の構造式の化合物Dでもよい。

WO 02/104080

(化合物D)

発光材料2としては前記Ir錯体Cを用いる。

5 化合物 C および I r 錯体 C を等量秤量し、メノウ乳鉢で結晶形を小さくしながら撹拌、混合して混合物粉体を作成する。この混合物粉体を蒸着用ボートに投入してホスト材料として CBP と共蒸着を行う。

上記の化合物 C および I r 錯体 C の混合物は重量比 7%になるようにホスト 材料と共蒸着する。

10

15

実施例6

本実施例では、素子構成として、図1Bに示す有機層が3層の素子を使用した。ガラス基板(透明基板15)上に100nmのITO(透明電極14)をパターニングした。そのITO基板上に、以下の有機層と電極層を10⁴Paの真空チャンパー内で抵抗加熱による真空蒸着し、連続製膜した。

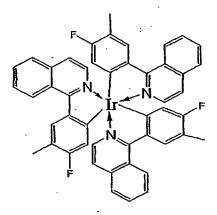
ホール輸送層13 (40 nm):FL03

発光層12 (40nm): ホスト材料+発光材料1+発光材料2 電子輸送層17 (50nm) Bphen 電子輸注入層16 (1nm): KF 金属電極層 (100nm): A1

20 対向する電極面積が3mm¹になるようにパターニングした。

本実施例においては、発光材料1としてIr錯体C、発光材料2としてIr 錯体H(次構造式)を用いた。 WO 02/104080

(Ir錯体H)



I r錯体CおよびI r錯体Hを等量秤量し、メノウ乳鉢で結晶形を小さくしながら撹拌、混合して混合物粉体を作成した。この混合物粉体を蒸着用ポートに投入してホスト材料としてCBPと共蒸着を行った。

上記のIr錯体の混合物は重量比7%となるように、ホスト材料と共蒸着し成膜した。

(比較例61)

発光材料としてIr錯体Cのみを用いて重量比7%となるように、ホスト材10 料と共蒸着し成膜した。

(比較例62)

発光材料として I r 錯体Hのみを重量比7%となるように、ホスト材料と共 蒸着し成膜した。

このような素子の評価結果を次表に示す。

15

表12

1		輝度10	初期10		
			·		0 0 cd/m²
発光材料	電圧(v)	電流効率	電力効率	での輝度	
		(cd/A)	(lm/W)	半減時間	
		·			(hour)
実施例 6	I r錯体C+I r錯体H	5.7	10.5	5.9	80
比較例 61	I r錯体C	5	7.6	4.8	50
比較例 62	I r錯体H	5.8	16.2	8.8	1.5

本実施例の素子では 100 cd/m^2 の発光輝度を出す駆動電圧は5.7 Vであった。比較例6105 Vと比べてやや高いものの、比較例6205.8 Vに比べて大幅に低電圧化されており、さらに電流効率においても10.5 cd/Aと比較例6107.6 cd/A、に比べて大幅に改善されている。これは電力効率においても同様であり、比較例6104.81 m/W、に比べて本実施例は5.91 m/Wと非常に高効率な素子を作成することに成功している。

さらに、その素子の初期輝度1000cd/m²からの連続駆動における輝 10 度半減時間も、比較例61の50時間、比較例62の1.5時間に比べて80 時間と大幅に改善することに成功している。

本実施例は電流効率、電圧効率では比較例62に劣っているが、比較例62 の発光色が赤方向に改善されている。比較例62の CIE 座標は(0.65,0.35) なのに対して本実施例では(0.68,0.33)であった。比較例61の発光は(0.68,0.33)と本実施例とほぼ同じであった。また輝度半減時間は比較例6 2の10倍以上の改善があり本発明の効果が特に大きいと考えられる。

本実施例に用いたイリジウム錯体のHOMO準位およびLUMO準位を調べると次表の様になっており、Ir錯体CのHOMO準位は-5.13eVで

WO 02/104080

あり、Ir錯体HのHOMO準位-5.19eVより高い。

一方、イリジウム錯体CのLUMO準位も-2.47eVとIr錯体HのLUMO準位-2.6eVよりより高くなっている。

本発明に用いた I r 錯体 C および I r 錯体 H の真空中での蒸発温度はそれぞれ、267度、230度であり、フッ素原子のついたイリジウム錯体の方が蒸発温度が低い。本発明の特徴の1つは、蒸発温度の異なる発光材料を混合して同一るつぼ上で蒸発させることにより、蒸着温度を低下でき、また蒸発時にクラスターサイズをより細かくすることができると考えられる。

さらに、本実施例の蒸着ボートに流す電流量を調べると、混合物の方が電流 10 量が低く素子作成時の熱による劣化が少なくなっていることが分かる。

この結果を次表に示した。

表13

発光材量	効率 cd/A	ボート電流 アンペア
lr錯体c	6.5	56.1
lr錯体c+lr錯体h	10	52.6

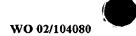
15 実施例7

本実施例では、素子構成として、実施例1に記載の条件で、図1Cに示す有機層が4層の素子を使用した。

CBPを発光層のホストとして用い、発光材料としてIr錯体Bを7重量の 濃度で、また非発光性化合物として化合物Aを3重量%を発光層にドープして 30 素子を作製した。ただしここで用いた化合物Aは素子を流れる電流を増大する 働きをもち、電流促進材料としての働きを兼ね備えている。

(比較例71)

化合物Aをドープしない以外は、実施例1と同様にして、素子を作製した。 これらの素子に10Vの直流電圧を印加して、そのときの電流および輝度を



測定した結果を次表に示す。

表14

	電流(mA/cm2)	輝度(cd/m2)
実施例7	50.1	386
比較例71	36.3	312

表14から、比較例71に比べて、実施例7の素子は電流・輝度が共に上昇し、非発光性化合物の添加効果、および電流促進材としての効果が確認された。 また、実施例7と比較例71の発光スペクトルはほぼ同じで、Ir錯体Bからの発光のみが観測された。

実施例8

発光層のホストとしてTAZを用い、非発光性化合物としてCBPを10重 10 量%、発光材料としてIr錯体Bを7重量%の濃度で発光層にドープして、素子を作製した。ただしここで用いたCBPは素子を流れる電流を増大する働きをもち、電流促進材料としての働きを兼ね備えている。

(比較例81)

CBPをドープしない以外は、実施例8と同様にして、素子を作製した。 これらの素子に10Vの直流電圧を印加して、そのときの電流および輝度を測 定した結果を次表に示す。

表15

15

20

	電流(mA/cm2)	輝度(cd/m2)
実施例8	6.56	140
比較例81	3.18	99.4

表15から、比較例81に比べて、実施例8の素子は電流・輝度が共に向上し、非発光性化合物の添加効果、および電流促進材としての効果が確認された。また実施例8と比較例81の発光スペクトルはほぼ同じで、Ir錯体Bからの発光のみが観測された。



実施例9

発光層の構成を除いて、先の実施例3に記載の素子と同様な素子を形成した。 発光層には、ホスト材料と発光材料および非発光性化合物の混合物を用いた。

本実施例においては、発光材料としてフェニルイソキノリンを配位子とした

5 Ir 錯体Cを、非発光性化合物として化合物3(次構造式)を用いた。

(化合物3)

I r 錯体Cおよび化合物3を等量秤量し、メノウ乳鉢で結晶形を小さくしながら撹拌、混合して混合物粉体を作成した。この混合物粉体を蒸着用ボートに投入して別な蒸着ボートにホスト材料としてCBPを準備し、共蒸着を行った。上記のI r 錯体Cの混合物は重量比20%になるようにホスト材料と共蒸着した。

本実施例の混合物の蒸着時の加熱容器に流れる電流を調べると低下しており、蒸発温度を大幅に下げることができた。このことは素子作成時の熱的なダ メージを軽減することができ、安定した素子の作成が可能になった。

本実施例に用いたイリジウム錯体のHOMO準位およびLUMO準位を調べると次表の様になっている。

表16

15

	Ir錯体C	化合物3
НОМО	-5.13	-5.38
LUMO	-2.47	-1.94
バンドギャッフ	2.66	3,44

20 発光材料である I r 錯体 C のバンドギャップは、非発光性化合物 3 よりも狭いことがわかる。

実施例10

発光層の構成を除いて、先の実施例3に記載の素子と同様な素子を形成した。 発光層には、ホスト材料と発光材料および非発光性化合物の混合物を用いた。

本実施例においては、発光材料として化合物 C、非発光性化合物としては前 5 記化合物3を用いる。

化合物 C および化合物 3 を等量秤量し、メノウ乳鉢で結晶形を小さくしながら撹拌、混合して混合物粉体を作成する。この混合物粉体を蒸着用ボートに投入して、ホスト材料である C B P と共蒸着を行う。上記の化合物 C および化合物 3 の混合物は重量比 7 %になるように、発光層を共蒸着した。

10

実施例11(比較例71)

本実施例では、発光層を除く素子構成として、実施例1に記載の条件で、図 1 Cに示す有機層が4層の素子を使用した。

発光層のホストとしてCBPを用い、発光材料としてIr錯体Bを7重量%、 電流促進材料として下記構造式で表されるPBDを3重量%の濃度で発光層 にドープして素子を作製した。

PBDをドープしない以外は、実施例1と同様にして、素子を作製した(比較例71)。

(PBDの構造式)

20

これらの素子に10Vの直流電圧を印加して、そのときの電流および輝度を測定した結果を表17に示す。



表17

	電流(mA/cm2)	輝度(cd/m2)
実施例11	62	450
比較例71	36.3	312

表17から、比較例71に比べて、実施例11の素子は電流・輝度が共に上昇し、電流促進材料の効果が確認された。また、実施例11と比較例71の発光スペクトルはほぼ同じで、Ir錯体Bからの発光のみが観測された。

5 この場合ホスト材料のCBPはホール輸送性が強く、電子輸送性の材料であるPBDなどをドープすることが、素子電流増大にとって効果的である。

その他本発明に用いられる電流促進材料としては、電子輸送性の材料として、 下記構造式を有するPySPyなどを用いることが可能であるが、これらに限 定されるものではない。

10 (PySPyの構造式)

実施例12(比較例81)

本実施例では、発光層を除く素子構成として、実施例1に記載の条件で、図 15 1 Cに示す有機層が4層の素子を使用した。

TAZを発光層のホストとして用い、発光材料としてIr錯体Bを7重量%、電流促進材料として下記構造式で表されるNPDを3重量%の濃度で発光層にドープして素子を作製した。

NPDをドープしない以外は、実施例12と同様にして、素子を作製した。



この構成は比較例81と同様である。

(NPDの構造式)

5 これらの素子に10 Vの直流電圧を印加して、そのときの電流および輝度を測 定した結果を表18に示す。

表18

	電流(mA/cm2)	輝度(cd/m2)
実施例12	82	180
比較例81	3.18	99.4

比較例81に比べて、実施例12の素子は電流・輝度が共に上昇し、電流促 10 進材料の効果が確認された。また、実施例12と比較例81の発光スペクトル はほぼ同じで、Ir錯体Bからの発光のみが観測された。

この場合、ホスト材料のTAZは電子輸送性材料であるために、電流促進材料としてはホール輸送性のNPDなどが素子電流を増加させるのに適している。

15 その他本発明の電流促進材料としては、ホール輸送性の材料として、下記構造式を有するm-MTDATAなどを用いることが可能であるが、これに限るものではない。

(m-MTDATAの化学構造式)

以上の実施例では、ホスト材料を用いる場合を説明したが、本発明において はホスト材料を含まない場合においても同様な効果を示す。

これらの結果、発光輝度、発光効率および発光寿命ともに、非発光性化合物 を用いない場合に比べてよい結果を示した。

産業上の利用可能性

15

10 以上説明したように、本発明によって、素子に流れる電流量を増加させることができ、また低電圧駆動を可能にし、輝度や発光効率の向上することが可能になった。

本発明の高効率な発光素子は、省エネルギーや高輝度が必要な製品に応用が可能である。応用例としては表示装置・照明装置やプリンターの光源、液晶表示装置のパックライトなどが考えられる。表示装置としては、省エネルギーや高視認性・軽量なフラットパネルディスプレイが可能となる。また、プリンターの光源としては、現在広く用いられているレーザビームプリンタのレーザー



光源部を、本発明の発光素子に置き換えることができる。独立にアドレスできる素子をアレイ上に配置し、感光ドラムに所望の露光を行うことで、画像形成する。本発明の素子を用いることで、装置体積を大幅に減少することができる。 照明装置やバックライトに関しては、本発明による省エネルギー効果が期待できる。



請求の範囲

- 1. 基板上に配置された陽極および陰極からなる電極と、前記電極間に 有機発光層を有する発光素子であって、前記有機発光層が発光材料とその分散 性を改善するためのドーパントを含むことを特徴とする発光素子。
- 2. 前記ドーパントが発光性化合物であり、かつ前記発光性化合物の発光波 長スペクトルが発光材料の発光波長スペクトルと主要な部分で重なりを有す ることを特徴とする請求の範囲第1項記載の発光素子。

10

- 3. 前記発光材料と前記発光性化合物の発光波長と量子収率との関係が、発光波長の短い方の量子収率が、発光波長の長い方の量子収率より大きいことを特徴とする請求の範囲第2項記載の発光素子。
- 15 4. 前記発光材料と前記発光性化合物の少なくとも一方が、金属錯体および /または有機化合物であることを特徴とする請求の範囲第2項記載の発光素子。
 - 5. 前記金属錯体および/または有機化合物のHOMO準位が異なることを 特徴とする請求の範囲第2項記載の発光素子。

20

- 6. 前記発光材料と前記発光性化合物のうちの少なくとも一種が、他方に対してHOMO準位とLUMO準位が共に低い準位を有する金属錯体および/または有機化合物であることを特徴とする請求の範囲第2項記載の発光素子。
- 25 7. 前記発光材料と前記発光性化合物の発光スペクトルのピーク波長の差が 30nm以内であることを特徴とする請求の範囲第2項記載の発光素子。



- 8. 前記発光材料と前記発光性化合物が、同一の配位子骨格を有し配位子骨格の置換基がそれぞれ異なる複数の金属錯体で構成されたことを特徴とする請求の範囲第4項記載の発光素子。
- 5 9. 前記発光材料と前記発光性化合物の中心金属が同一の金属であることを 特徴とする請求の範囲第8項記載の発光素子。
 - 10. 前記中心金属がイリジウムであることを特徴とする請求の範囲第9項記載の発光素子。

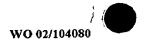
- 11. 前記置換基がフッ素原子であることを特徴とする請求の範囲第8項記載の発光素子。
- 12. 前記配位子骨格がイソキノリン骨格を有することを特徴とする請求の 15 範囲第8項記載の発光素子。
 - 13. 前記発光材料と前記発光性化合物の少なくとも1つが燐光発光することを特徴とする請求の範囲第2項記載の発光素子。
- 20 14. 前記発光材料と前記発光性化合物の少なくとも1つが、異なる配位子 が同一金属に配位した複数配位子を有する金属錯体であることを特徴とする 請求の範囲第4項記載の発光素子。
- 15. 前記発光材料と前記発光性化合物を同一の容器内に混合し、真空蒸着 25 により前記有機発光層を形成することを特徴とする請求の範囲第2項記載の 発光素子の製造方法。

- 16. 前記発光材料と前記発光性化合物の少なくとも1つがフッ素原子を含有することを特徴とする請求の範囲第15項記載の発光素子の製造方法。
- 17. 前記ドーパントが非発光性化合物からなることを特徴とする請求の範 5 囲第1項記載の発光素子。
 - 18. 前記非発光性化合物のバンドギャップが前記発光材料のバンドギャップよりも広いことを特徴とする請求の範囲第17項記載の発光素子。
- 10 19. 前記発光材料と非発光性化合物の割合を、有機発光層内の場所により変化させたことを特徴とする請求の範囲第17項記載の発光素子。
 - 20. 前記非発光性化合物がフッ素原子を含有することを特徴とする請求の範囲第17項記載の発光素子。

- 21. 前記発光材料が燐光発光材料であることを特徴とする請求の範囲第17項記載の発光素子。
- 22. 発光材料と少なくとも1種類の非発光性化合物を混合し、該混合物を 20 加熱して真空蒸着することにより前記有機発光層を形成することを特徴とす る請求の範囲第17項記載の発光素子の製造方法。
 - 23. 前記発光材料と非発光性化合物の少なくとも1つがフッ素原子を含有することを特徴とする請求の範囲第22項記載の発光素子の製造方法。

25

24. 前記ドーパントが電流促進材料からなることを特徴とする請求の範囲



- 第1項記載の発光素子。
- 25. 前記電流促進材料が発光性化合物であり、その量子収率が前記発光材料よりも低いことを特徴とする請求の範囲第24項記載の発光素子。

- 26. 前記電流促進材料と前記発光材料との発光スペクトルのピーク波長の差が30nm以下であることを特徴とする請求の範囲第24項記載の発光素子。
- 10 27. 前記電流促進材料のバンドギャップが前記発光材料のバンドギャップ よりも大きいことを特徴とする請求の範囲第24項記載の発光素子。
- 28. 前記発光材料の濃度および/または前記電流促進材料の割合を、有機発光層内の場所により変化させたことを特徴とする請求の範囲第24項記載 の発光素子。
 - 29. 前記発光材料と前記電流促進材料の少なくとも一方が、燐光発光材料であることを特徴とする請求の範囲第24項記載の発光素子。
- 20 3 0. 前記有機発光層が、発光材料と電流促進材料およびホスト材料を含み、 前記ホスト材料がホール輸送性材料であり、前記電流促進材料が電子輸送性材 料であることを特徴とする請求の範囲第 2 4 項記載の発光素子。
- 31. 前記有機発光層が、発光材料と電流促進材料およびホスト材料を含み、 25 前記ホスト材料が電子輸送性材料であり、前記電流促進材料がホール輸送性材料であることを特徴とする請求の範囲第24項記載の発光素子。

FIG. 1A

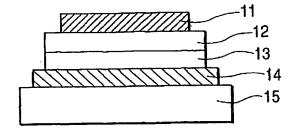


FIG. 1B

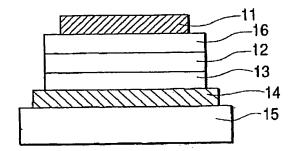


FIG. 1C

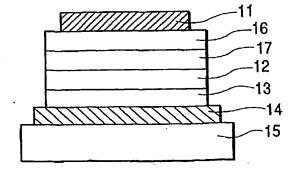


FIG. 2

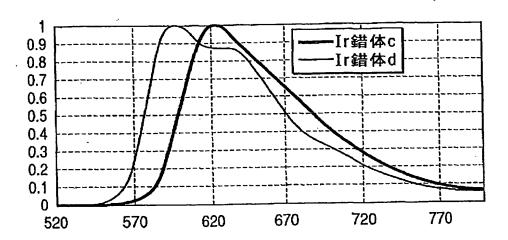
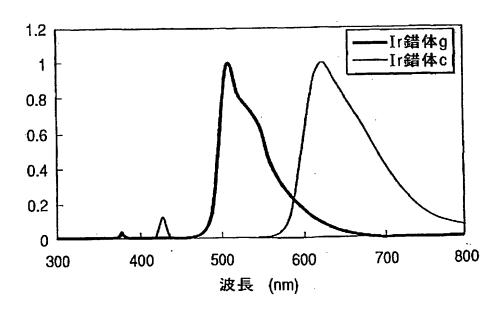


FIG. 3





International application No.
PCT/JP02/05891

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H05B33/14, C09K11/06					
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIELDS	SEARCHED				
Minimum do	cumentation searched (classification system followed by C1 ⁷ H05B33/14, C09K11/06	classification symbols)			
Documentati	on searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included i	in the fields searched		
Jitsu Kokai	yo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2002		
Electronic d	ata base consulted during the international search (name us (STN), REGISTRY (STN), ISI Web	of data base and, where practicable, sear of Science	ch terms used)		
<u>*</u> -					
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.		
X A	M.A. Baldo, M.E. Thompson, and "High-efficiency fluorescent of devices using a phosphorescent	organic light-emitting to sensitizer"	1 2-31		
-	NATURE, Vol.403, 17 February, pages 750 to 753	2000 (17.02.00),			
х	JP 2000-351966 A (Fuji Photo 19 December, 2000 (19.12.00),		1-2,4-6, 13,15 3,7-12,14,		
A	Page 26, column 49, lines 1 t & US 6310231 A	16			
P,X P,A	JP 2001-319780 A (Fuji Photo 16 November, 2001 (16.11.01), Full text	Film Co., Ltd.),	1 2-31		
	& US 2001/0053462 A		-		
			·		
X Furth	ner documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
"A" docum	al categories of cited documents: nent defining the general state of the art which is not	"I" later document published after the in priority date and not in conflict with understand the principle or theory un	the application but cited to deriving the invention		
"E" carlier	ered to be of particular relevance r document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered novel or cann	e claimed invention cannot be lesed to involve an inventive me		
cited i	nent which may throw doubts on priority claim(s) or which is to establish the publication date of another citation or other if reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive at combined with one or more other suc	e claimed invention cannot be ep when the document is ch documents, such		
"P" docum	means combination being obvious to a person skillen in the ant document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family				
Date of the	he priority date claimed actual completion of the international search July, 2002 (11.07.02)	Date of mailing of the international sea 30 July, 2002 (30.	orch report 07.02)		
Name and Jap	Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer				
Facsimile 1	No.	Telephone No.			

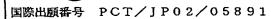


national application No.
PCT/JP02/05891

		Relevant to claim No.
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,X P,A	JP 2001-247859 A (Fuji Photo Film Co., Ltd.), 14 September, 2001 (14.09.01), & JP 2001-345183 A & US 2001/0019782 A	2-31
P,X P,A	JP 2001-313178 A (Pioneer Electronic Corp.), 09 November, 2001 (09.11.01), (Family: none)	1 2-31
P,X P,A	JP 2001-313179 A (Mitsubishi Chemical Corp.), 09 November, 2001 (09.11.01), (Family: none)	1 2-31
P,X P,A	JP 2001-257076 A (TDK Corp.), 21 September, 2001 (21.09.01), (Family: none)	1 2-31
x	JP 11-35532 A (Canon Inc.), 09 February, 1999 (09.02.99), Page 19, compound No.48 to page 20, compound No.51; page 33, column 63, line 24 to column 64, line 24 & EP 879868 B & DE 69804529 E	1,17-18, 24-25,27
x	JP 11-288783 A (Mitsui Chemicals, Ltd.), 19 October, 1999 (19.10.99), Claims; page 40, G-24; page 51, column 99, line 47 to page 53, line 13 (Family: none)	1,17-18, 24-25,27
P,A	JP 2002-100476 A (Fuji Photo Film Co., Ltd.), 05 April, 2002 (05.04.02), & EP 1175128 A & US 2002/0028329 A	1-31
x	M.A. Baldo, et al., "Very high-efficiency green organic light-emitting devices based on electrophosphorescence", Appl.Phy.Lett., Vol.75, No.1, 05 July, 1999 (05.07.99), pages 4 to 6	1,17-18, 24-25,27
х	T.Tsutsui, et al., "High Quantum Efficiency in Organic Light-Emitting Devices with Iridium-Complex as a Triplet Emissive Center", Jpn.J.Appl.Phys., Part 2, No.12B, Vol.38, 15 December, 1999 (15.12.99), pages L1502 to L1504	1,17-18, 24-25,27
A	C.Adachi, et al., "High-efficiency organic electro-phosphorescent devices with tris(2-phenylpyridine)iridium doped into electron-transporting materials", Appl.Phys.Lett., Vol.77, No.6, 07 August, 2000 (07.08.00), pages 904 to 906	1-31
A	C.Adachi, et al., "High-efficiency red electro- phosphorescence devices", Appl.Phys.Lett., Vol.78, No.11, 12 March, 2001 (12.03.01), pages 1622 to 1624	1-31

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)





A. 発明の刷	はする分野の分類(国際特許分類(IPC))		
Int.	C1' H05B 33/14, C09K1	1/06	
B. 調査を行	テった 分野		
	是小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int.	C1' H05B 33/14, C09K1	1/06	
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの		
日本国	実用新案公報 1922-1996年	•	
	公開実用新案公報 1971-2002年 実用新案登録公報 1996-2001年		
日本国	登録実用新案公報 1994-2002年		
CAp REG	用した電子データベース(データベースの名称、 lus (STN) ISTRY (STN) b of Science	調査に使用した用語)	
こ 関連する	ると認められる文献		
引用文献の			関連する
カテゴリー*			請求の範囲の番号
X	M. A. Baldo, M. E. Thompson, and S. R.		1 2-31
A	"High-efficiency fluorescent orga using a phosphorescent sensitizer		2 31
	NATURE, Vol. 403, 17. Feb. 2000, pp.		İ
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		(ata 1 constitues a substitution Add)	1 0 4 6 10
X	JP 2000-351966 A		1-2, 4-6, 13, 15
A	2000.12.19,第26頁49欄	T 1.1 — 201 1	3, 7-12, 14, 16
	&03 0310231 A	•	}
			<u> </u>
図 C欄の続	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
* 引用文献		の日の後に公表された文献	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1 - 1	連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表 出願と矛盾するものではなく、	
しています。 「E」国際出	願日前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のために引用するもの	
	公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないと考	
	主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行くは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、	
文献 (理由を付す)	上の文献との、当業者にとって	自明である組合せに
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査報告の発送日 3007 00			
11. 07. 02			
	の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	3X 9529
日本	国特許庁(ISA/JP)	今関 雅子 (2)第	יענץ
東京	郵便番号100-8915 都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3371
	en e la recipione de la companya de	<u> </u>	



į	国際課	直 直 報		
,	251 12	> 1- Y -	L+A	

関連すると認められる文献	
	関連する 請求の範囲の番号
JP 2001-319780 A (富士写真フィルム株式会社) 2001. 11. 16, 全文 &US 2001/0053462 A	1 2-31
JP 2001-247859 A (富士写真フィルム株式会社) 2001. 09. 14 &JP 2001-345183 A &US 2001/0019782 A	1 2-31
JP 2001-313178 A (パイオニア株式会社) 2001.11.09 (ファミリーなし)	1 2-31
JP 2001-313179 A (三菱化学株式会社) 2001.11.09 (ファミリーなし)	1 2–31
JP 2001-257076 A (ティーディーケイ株式会社) 2001.09.21 (ファミリーなし)	1 2-31
JP 11-35532 A (キャノン株式会社) 1999.02.09,第19頁化合物No.48-第20頁化合物No.51, 第33頁63欄24行-64欄24行 & EP 879868 B DE 69804529 E	1, 17–18, 24–25, 27
JP 11-288783 A (三井化学株式会社) 1999.10.19,特許請求の範囲,第40頁G-24,第51頁99欄 47行-第53頁13行 (ファミリーなし)	1, 17–18, 24–25, 27
JP 2002-100476 A (富士写真フィルム株式会社) 2002. 04. 05 &EP 1175128 A &US 2002/0028329 A	1-31
M. A. Baldo, et.al., "Very high-efficiency green organic light-emitting devices based on electrophosphorescence", Appl. Phy. Lett, Vol. 75, No. 1, 5 July 1999, pp. 4-6. T. Tsutsui, et.al., "High Quantum Efficiency in Organic Light-Emitting Devices with Iridium-Complex as a Triplet Emissive Center", Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, No. 12B, Vol. 38,	1, 17–18, 24–25, 27 1, 17–18, 24–25, 27
	2001.11.16,全文 &US 2001/0053462 A JP 2001-247859 A (富士写真フィルム株式会社) 2001.09.14 &JP 2001-345183 A &US 2001/0019782 A JP 2001-313178 A (パイオニア株式会社) 2001.11.09 (ファミリーなし) JP 2001-313179 A (三菱化学株式会社) 2001.11.09 (ファミリーなし) JP 2001-257076 A (ティディーケイ株式会社) 2001.11.09 (ファミリーなし) JP 2001-257076 A (ティディーケイ株式会社) 2001.09.21 (ファミリーなし) JP 11-35532 A (キャノン株式会社) 1999.02.09,第19頁化合物No.48-第20頁化合物No.51, 第33頁63欄24行-64欄24行 &EP 879868 B DE 69804529 E JP 11-288783 A (三井化学株式会社) 1999.10.19,特許請求の範囲,第40頁6-24,第51頁9欄47行-第53頁13行 (ファミリーなし) JP 2002-100476 A (富士写真フィルム株式会社) 2002.04.05 &EP 1175128 A WM.A.Baldo, et.al., "Very high-efficiency green organic light-emitting devices based on electrophosphorescence", Appl. Phy. Lett., Vol. 75, No. 1, 5 July 1999, pp. 4-6 T. Tsutsui, et.al., "High Quantum Efficiency in Organic Light-Emitting Devices with Iridium-Complex as a Triplet Emissive



	四次四点の一点の一点の一点の一点の一点の一点の一点の一点の一点の一点の一点の一点の一点			
C(続き).				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
A	C. Adachi, et.al., "High-efficiency organic electro- phosphorescent devices with tris(2-phenylpyridine)iridium doped into electron-transporting materials", Appl. Phys. Lett., Vol. 77, No. 6, 7. Aug. 2000, pp. 904-906	1-31		
A	C. Adachi, et.al., "High-efficiency red electro- phosphorescence devices", Appl. Phys. Lett., Vol. 78, No. 11, 12 March 2001, pp. 1622-1624	1-31		
İ				
:				
	·			